

Title (en)  
SEMICONDUCTOR MEMORY.

Title (de)  
HALBLEITERSPEICHERVORRICHTUNG.

Title (fr)  
MEMOIRE A SEMI-CONDUCTEURS.

Publication  
**EP 0163721 A1 19851211 (EN)**

Application  
**EP 85900277 A 19841114**

Priority  
US 55766383 A 19831202

Abstract (en)  
[origin: WO8502314A2] Inclusion of two or more sense amplifiers in a column of a solid state memory. In one embodiment, and additional sense amplifier (100) is provided on each column of a dynamic access memory (RAM). In other embodiment, a static memory has two or more sense amplifiers (S311, S321) located along a column. The sense amplifiers may be activated by the same column access strobe (CAS) pulse may be activated sequentially by separate strobe pulses (T1, T2). Other implementations of the present technique in ROMs, EPROMs, etc. are possible. The additional sense amplifiers provide improved signal transfer speed.

Abstract (fr)  
Inclusion de deux amplificateurs de détection ou davantage dans une colonne d'une mémoire à semi-conducteurs. Dans un mode de réalisation, un amplificateur de détection supplémentaire (100) est disposé sur chaque colonne d'une mémoire vive dynamique (RAM). Dans une variante, une mémoire statique possède deux amplificateurs de détection (S311, S321) ou davantage, disposés le long d'une colonne. Les amplificateurs de détection peuvent être actionnés par la même impulsion de synchronisation d'accès à la colonne (CAS) ou ils peuvent être actionnés de manière séquentielle par des impulsions séparées de synchronisation (T1, T2). D'autres implantations en ROM, EPROM, etc., de la technique ci-décrite sont également possibles. Les amplificateurs de détection supplémentaires permettent d'augmenter la vitesse de transfert des signaux.

IPC 1-7  
**G11C 7/00**

IPC 8 full level  
**G11C 11/34** (2006.01); **G11C 7/06** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**G11C 7/065** (2013.01)

Citation (search report)  
See references of WO 8502314A2

Designated contracting state (EPC)  
BE DE FR NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8502314 A2 19850606; WO 8502314 A3 19850704; EP 0163721 A1 19851211; JP S61500573 A 19860327**

DOCDB simple family (application)  
**US 8401839 W 19841114; EP 85900277 A 19841114; JP 50448784 A 19841114**